PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-184718

(43)Date of publication of application: 16.07.1996

(51)Int.CI.

G02B 6/12 C08G 73/10 G02B 6/13

(21)Application number: 06-328729

(71)Applicant: HOECHST JAPAN LTD

(22)Date of filing:

28.12.1994

(72)Inventor: OKANIWA KO

(54) OPTICAL WAVEGUIDE ELEMENT AND MANUFACTURE THEREOF

(57)Abstract:

PURPOSE: To form the excellent optical waveguide which has a little light loss by using specific polyimide, obtained from tetracarboxylic acid or its derivative and diamine acid, as a constituent element of the optical waveguide.

CONSTITUTION: A waveguide layer contains photosensitive fluorine-containing polyimide having ≥1 kind of repetitive unit shown by a formula I. In the formula, R1 is anyone of groups expressed by a formula II, R2 anyone of groups expressed by a formula IV, and Rf, R'f, and R"f some of groups expressed by a formula 5. The photosensitive fluorine-containing polyimide having repetitive units shown by the formula I can contain ≥2 different kinds of the formulas II and III in R1 and/or R2 as the repetitive units.

Ī.

П

Ŕ

d da k dig

KON NKK

Professional State of the second seco

සියක්දී 1. ඒ ප්රිල්(ස්වේස්ස්සේ පැමි (කුරු) (සිටින ක්රේම් විස්ත්රම් දින 2 ක්රේම් මිතුම් විස්ත්රම් විස්ත්ර

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

	, ac				5. 1.
					. ,
	-				,
•					
*					
*					
					, Ģ
		2		* 4	
			·		
				4	

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-184718

(43)公開日 平成8年(1996)7月16日

技術表示箇所 (51) Int.Cl.⁶ 識別記号 庁内整理番号 FΙ G 0 2 B 6/12 C08G 73/10 NTF G 0 2 B 6/13 G02B 6/12 Ν M 審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 9 頁) (71)出廣人 000113137 (21)出顧番号 特顯平6-328729 ヘキストジャパン株式会社 (22)出顧日 平成6年(1994)12月28日 東京都港区赤坂8丁目10番16号 (72)発明者 岡庭 香 埼玉県川越市南台1-3-2 ヘキストジ ャパン株式会社先端材料技術研究所内 (74)代理人 弁理士 湯浅 恭三 (外6名)

(54) [発明の名称] 光導波路素子およびその製造方法

(57)【要約】

【構成】 光導波路素子の導波層、クラッド層、接着性 増強層の材料として特定の含フッ素ポリイミドを使用する。

【効集】 石英系導波路ではできない光薄波路素子作製プロセスの簡単化、低コスト化、フレキシブル化を図ることができ、従来のプラスチック系導波路では遠成できなかった単一モード性、1.3ミクロン帯の低損失化、商耐湿性化が可能である。

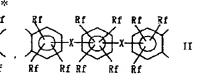
【特許請求の範囲】

【請求項1】 導波層が下記一般式1

* (武中、R¹は下記式日 【化2】

[(61]

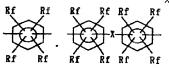
$$\begin{bmatrix} & & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ &$$

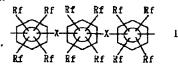


で表される基のうちいずれかの基であり、R2は下記式し

※【化3】

11





Ш

下記式IV

で表される基のうちいずれかの基であり、Xは独立して 20★で表される基のうちいずれかの基であり、Rf、R'f およびR" / はそれぞれ独立して下記式V

[K4]

においては少なくとも1つのRIが R*である)

[化5]

Y

で表される基のうちいずれかの基である)で表される繰 り返し単位を1種またはそれ以上有する感光性含フッ素 ポリイミドを含むことを特徴とする光導波路素子。

【請求項2】 クラッド層が下記一般式VI

$$\begin{array}{c|c}
 & CO \\
\hline
 & CO \\
\hline
 & CO \\
\hline
 & CO \\
\hline
 & N-R^2
\end{array}$$

(式中、R1は前記式口と同じ意味を表し、R2は前記式 IIIと同じ意味を表し(ただし、R²においてどのR f も 感光性基R⁶でない場合を含む)、Xは前記式IVと同じ 意味を表し、並びにRf、R'fおよびR"fは前記式 Vと同じ意味を表す)で表される繰り返し単位を1種ま たはそれ以上有する含フッ素ポリイミドを含むことを特 徴とする光導波路素子。

【請求項3】 接著性增強層が下記一般式VII 【化7】

VII

(武中、R1は前記式目と同じ意味を表し、各繰り返し 単位のR2のうち一部は下記式VIII

【化8】

(武中、Rは独立してアルキル基を表す)で表される基 であり、他のR²は前記式IIIと同じ意味を表す(この場 合、Xは前記式IVと同じ意味を表し、並びにRf、R' 「およびR"」は前記式Vと同じ意味を表すが、R2に おいてどのRfも感光性基R®でない場合を含む))で 表される繰り返し単位を1種またはそれ以上有するシロ 50 キサン変性含フッ素ポリイミドを含むことを特徴とする

3

光導波路素子。

【請求項4】 請求項1に記載の一般式1で表される感光性含フッ素ポリイミドの感光性基と反応しうる低分子 集の添加剤を、このポリマー溶液中に溶解し、これを適当な基板上に施用し、溶媒を蒸発させ、導波路パターン のあるフォトマスクを通して蒸光し、未露光の部分の添加剤を熱によって除去することにより、露光部分と未露 光部分との屈折率差を生じさせ、溶波チャネルを形成することを特徴とする光源波路素子の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、高性能な光導波路素子を安価に作製しうる材料および当該光導波路素子の製造方法に関するものである。

100021

【従来の技術】近年急速に関心の高まりつつある光通信 において、重要な光部品として光分岐結合器 (光カブ ラ)、光合分波器、光アイソレータ、光ファイバーアン ブ等があるが、このうち光カブラ、光合分波器はこれま で石英系光ファイバーの熱融着型が主流であった。とこ ろが、特に光カプラの場合には熱融着型が基本的に1入 カ2出力(1 X 2 カブラ)であるため、出力ポートの数 が増えれば、1×2カプラを多数接続しなければならな い。このため、歩留りがきわめて悪いばかりでなく、カ プラ自身の大きさが大きくなるという不都合がある。通 償システムをできるだけ小さくしたいという要請におい て、単なる分岐を担うカプラが大きいのは致命的であ る。そこで、出力ボート数を増やしても素子自体が大き くならない導波路型カプラが有望視されている。現在ま でに最も高性能で信頼性の高い受動型光導波路素子はガ ラス導波路である。これにはコーニングをはじめとする イオン交換法とNTTをはじめとする火災堆積法がある が、どちらの手法も導波路作製プロセスが繁雑で数多く の段階を経なければならず、また1000℃以上の高温 のプロセスを含む。このため案子自体が高価になり、広 く普及することに対して除害となっている。また将来の 技術としてコンピュータ内の光配線があるが、ガラス導 波路では柔軟性がないためこの応用は困難である。

【0003】このような理由から、ポリマー材料による 光導波路作製の検討も数多くなされている。ところが、 40 ポリマー材料を光導波路索子に応用するためには幾つか の困難な点がある。そのひとつとしては、有機物特有の C-日伸縮振動の高調波が光通信で使用される近赤外領 域(1.2-1.6µm)に吸収をもち、光根失が大き いことが挙げられる。この点を解決するためによく知ら れた光学ポリマーであるPMMA(ポリメチルメタクリ レート)やPS(ポリスチレン)の水装を頂水素やフッ 素で酸換することが試みられているが、光学的にも耐熱 性の点からも問題がある。ポリイミド樹脂は、最も耐熱 性にすぐれており、これまでに光導波路素子への応用が 50 検討されている。ところで、通常のボリイミド樹脂は屈 折率が高く、これを薄波路材料として用いた時には、石 英の光ファイバーの屈折率と大きく遂い、このことが光 ファイバー、導波路間の光結合損失を大きくする原因と なっている。また、一般にボリイミド樹脂は吸湿しやす く素子の性能劣化を引き起こしやすい。さらに、膜にし た時の複屈折性が大きく、偏光依存性をもった導波路素 子となってしまう。

【0004】これらポリマーの問題点を克服すべく、含フッ素ポリイミドの薄波路への応用が検討されている(例えば、特開平2-281037号公報、特開平4-8734号公報、特開平4-9807号公報、特開平5-164929号公報および特開平6-51146号公報等を参照)。ポリイミドにフッ案を導入することは、高耐熱性を保ったまま、光通信で用いられる波長格における吸収損失を低減することのほか、低風折率化、低吸湿性化に対して有効であり、ポリマー光導波路素子の最も有望な手段といえる。しかしながら、これらの方法では、いずれも導波路バターンのレリーフ構造をつくるのに通常のリングラフィーの手法を用いているため、導波路作製プロセスのステップ数が多くなり、製造コストや歩留りに影響する。

【0005】製造プロセスの簡便性を考慮に入れた含フッ素ポリイミド樽波路については、特開平4-328127号公報に開示されている。同公報には、含フッ素ポリイミド前駆体であるポリアミド酸に感光性基をエステル結合させた感光性含フッ素化ポリイミド前駆体が記載されている。この材料で考えうる尊波路作製プロセスは、まずこのポリイミド前駆体を基板に膨状に施用し、溶媒を蒸笼させ、導波路パターンのあるフォトマスクを通し露光し、未霧光の部分を適当な溶媒で現像し、残ったレリーフ構造を高温で熱し、イミド化し固定する。ところが、このイミド化の際に感光性基からなるアルコールが遊離し、出来上がったレリーフ構造が収縮する。このことは特にY分岐などの微細な構造に対して致命的な欠陥を与える。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】以上の従来技術の問題点を解決すべく、本発明者らは光薄波路の適用を目指して種々のポリイミドを合成して適用性を検討した結果、テトラカルボン酸またはその誘導体とジアミンとから得られる特定のボリイミドを光導波路の構成要素として用いることによって光損失の少ない良好な光導波路が形成できることを見いだした。本発明はこの知見に基づいて完成したものである。一般に、準波路はコア部分に屈折率の高い導波層を設け、そのまわりにクラッド層を設けることによって形成され、必要に応じて接着性増強層を設けるが、本発明はこれらの各層に好適な材料に関するものである。

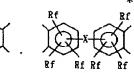
【0007】すなわち、本発明の第1の態様は、導波層

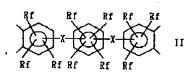
が下記一般式1

[化9]

* (式中、R: は下記式日 【化10】

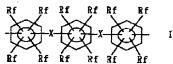






で表される基のうちいずれかの基であり、R2は下記式|

※【化11】



で表される基のうちいずれかの基であり、Xは独立して 下記式Ⅳ

【化12】 0 R'f -0-, -c-, -ç-, -so₂-, -s-, -0-R'f★で表される基のうちいずれかの基であり、Rf、R'f およびR"fはそれぞれ独立して下記式V 【化13】

(B^{*}は慈光性基を表し、B²(式III) こおいては少なくとも1つのRfが

R" f= -CF2-

で表される基のうちいずれかの基である)で表される繰 り返し単位を1種またはそれ以上有する感光性含フッ素 ポリイミドを含むことを特徴とする光導波路案子に関す る。前記…般式1で表される繰り返し単位を有する感光 性含フッ素ポリイミドにおいて該繰り返し単位のR¹お よび/またはR2はそれぞれ式11、式111の異なる2種類 以上を含むことができる。

【0008】本発明の第2の態様は、クラッド層が下記 一般式VI

(式中、R1は前記式目と同じ意味を表し、R2は前記式 IIIと同じ意味を表し(ただし、R2においてどのR1も 感光性基R®でない場合を含む)、Xは前記式IVと同じ 意味を表し、並びにRf、R'fおよびR"fは前記式 Vと同じ意味を表す)で表される繰り返し単位を1種ま 50 たはそれ以上有する含フッ素ポリイミド前駆体を用いる ことを特徴とする光導波路素子に関する。前記一般式VI で表される繰り返し単位を有する感光性含フッ素ポリイ ミドにおいて該繰り返し単位のR¹および/またはR²は それぞれ式11、式111の異なる2種類以上を含むことがで

【0009】本発明の第3の態様は、接着性増強層が下 記一般式VII

40 【化15】

$$\begin{bmatrix} C_{0} \\ C_{0} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_$$

(武中、R¹は前記式日と間じ意味を表し、各繰り返し 単位のR²のうち一部は下記式VIII

[1216]

(武中、Rはアルキル基を表す)で表される基であり、 他のR²は前記式目1と同じ意味を表す(この場合、Xは 前記式IVと同じ意味を表し、並びにRf、R'fおよび R" 子は前記式Vと同じ意味を表すが、R2においてど のRIも感光性基R®でない場合を含む))で表される 繰り返し単位を1種またはそれ以上有するシロキサン変 性含フッ素ポリイミドを含むことを特徴とする光導波路 素子に関する。前記…般式VIIで表される繰り返し単位 を有する巡光性含ツッ素ポリイミドにおいて該繰り返し 単位のR¹および/またはR²はそれぞれ式口、式口の異 なる2種類以上を含むことができる。

【0010】本発明の第4の態様は、前記一般式Ⅰで表 される繰り返し単位を1種またはそれ以上有する感光性 含フッ素ボリイミドの感光性基と反応しうる低分子量の 添加剤を、このボリマー溶液中に溶解し、これを適当な 基板上に施用し、溶媒を蒸発させ、導波路パターンのあ るフォトマスクを通して観光し、未露光の部分の添加剤 を熟によって除去することにより、露光部分と未露光部 分との屈折率差を生じさせ、導波チャネルを形成するこ とを特徴とする光導波路素子の製造方法に関する。

【0011】一般式1、VIおよびVIIにおいて、R¹およ び/またはR2が表わす基においてRfが-R0である場 合、R⁰は感光性基を意味する。R⁰の具体例としては、 アクリロイル基、シンナモイル基、シンナミリデン基、 カルコン残基、イソクマリン残基、2、5-ジメトキシ スチルベン残蒸、スチリルピリジウム残基、テミン残 基、aーフェニルマレイミド基、アントラセン残基、2 - ピロン栽集、o-ナフトキノンジアジド残基、o-ナ フトキノンジアジドスルホン酸基を挙げることができ る。また、光酸発生剤の存在下ではグリシジル蒸もRG とみなすことが可能である。

【0012】特に好ましいR1の例としては、2,2-ビスフェニルヘキサフルオコプロパン残基、2, 2ービ ス (4- (4' -フェノキシ) フェニル) ヘキサフルオ ロプロパン残基などをを挙げることができる。

【0013】特に好ましいR²の例としては、2、2-ピスフェニルヘキサフルオコプロパン残基、2, 2ービ ス (4- (4) -フェノキシ) フェニル) ヘキサフルオ ロプロバン残基などをを挙げることができる。

【0014】一般式VIIにおける式VIIIで表される基の 置換基Rはアルキル基を意味しそれぞれのRは同一でも 異なってもよい。好ましいRの例としては、メチル基、 エチル蕉、メトキシ墓、エトキシ燕、nープロピル基、 イソプロピル基等を挙げることができ、特に好ましい基 はメチル基である。

【0015】本発明で用いる…般式I、VIまたはVIIで

表される繰り返し単位を有するボリマーにおいて、繰り 返し単位を構成する要素であるR¹はすべて同一であっ てもよく、または式目の異なる2種類以上の基を含んで いてもよい。 同様に、 R2はすべて同…であってもよ く、または式口1の異なる2種類以上の基を含んでいて もよい。また、これらの一般式で表される繰り返し単位 を有するポリマーの分子数は特に限定されない。一般式 VIIで表される繰り返し単位を有するボリマーにおい て、R²は…部が式VIIIで表される基であり、残りは式1 1で表される基からなるが、両者の割合は特に限定され ず任意の比率のボリマーを利用することができる。

8

【0016】前記··・般式1、VIおよびVIIの含フッ要求 リイミドやそれらの前駆体を製造する時に使用するテト ラカルボン酸またはその誘導体としては、分子内のアル キル基、フェニル環等の炭素に結合する1.価元素をフッ 素またはパーフルオロアルキル基としたものであればど のようなものであってもよい。

【0017】テトラカルボン酸並びにその誘導体として の酸無水物、酸塩化物、エステル化物等としては次のよ うなものが挙げられる。ここではテトラカルボン酸とし ての例を挙げる。(トリフルオロメチル) ビロメリット 酸、ジ(トリフルオロメチル)ピロメリット酸、ジ (へ プタフルオロプロピル) ピロメリット酸、ペンタフルオ ロエチルピロメリット酸、ビス (3, 5ージ (トリフル オロメチル) フェノキシンピロメリット酸、2、3、 3', 4'-ピフェニルテトラカルボン酸、3, 3' 4, 4'ーテトラカルボキシジフェニルエーテル、2. 3, 3', 4'ーテトラカルボキシジフェニルエーテ ル、3,3',4,4'ーベンソフェノンテトラカルボ ン酸、2、3、6、7-デトラカルボキシナフタレン、 30 1, 4, 5, 7ーテトラカルボキシナフタレン、1. 4, 5, 6ーテトラカルボキシナフタレン、3, 3', 4, 4'ーテトラカルボキシジフェニルメタン、3、 3', 4、4'ーテトラカルボキシジフェニルスルホ ン、2,2ービス(3,4ージカルボキシフェニル)ナ ロパン、2、2-ビス(3,4-ジカルボキシフェニ ル) ヘキサフルオロプロパン、5、5'ーピス(トリフ ルオロメチル) -3, 3', 4, 4' -テトラカルボキ シジフェニル、2、2',5,5'ーテトラキス(トリ フルオロメチル) -3, 3', 4, 4'ーテトラカルボ キシジフェニル、5,5'-ビス(トリフルオロメチ ル) -3, 3', 4, 4'-テトラカルボキシジフェニ ルエーテル、5、5、-ビス(トリフルオロメチル)-3, 3', 4, 4'ーテトラカルボキシベンソフェノ ン、ピス ((トリフルオロメチル) ジカルボキシフェノ キシ) ベンゼン、ビス ((トリフルオロメチル) ジカル ボキシフェノキシ〉 (トリフルオロメチル) ベンゼン、 ビス (ジカルボキシフェノキシ) (トリフルオロメチ ル) ベンゼン、ビス (ジカルボキシフェノキシ) ビス (トリフルオロメチル) ベンゼン、ビス (ジカルボキシ

50

10

フェノキシ) テトラキス (トリフルオロメチル) ベンゼ ン、3,4,9,10-テトラカルボキシベリレン、 2, 2 -- ビス {4 -- (3, 4 -- ジカルボキシフェノキ シ) フェニル) プロパン、ブタンテトラカルボン酸、シ クロベンタンテトラカルボン酸、2,2ービス{4-(3, 4 - ジカルボキシフェノキシ) フェニル) ヘキサ フルオロプロバン、ピス ((トリフルオロメチル) ジカ ルボキシフェノキシ》ピフェニル、ピス { (トリフルオ ロメチル) ジカルボキシフェノキシトビス (トリフルオ ロメチル) ビフェニル、ビス ((トリフルオロメチル) ジカルボキシフェノキシ ジフェニルエーテル、ビス (ジカルボキシフェノキシ) ビス (トリフルオロメチ ル) ビフェニル、ビス (3, 4ージカルボキシフェニ ル) ジメチルシラン、1, 3-ビス(3, 4-ジカルボ キシフェニル) テトラメチルジシロキサン、ジフルオロ ピロメリット酸、1,4-ビス(3,4-ジカルボキシ トリフルオロフェノキシ) テトラフルオロベンゼン、 1, 4-ビス(3, 4-ジカルボキシトリフルオロフェ ノキシ) オクタフルオロビフェニルなどである。 【0018】ジアミンとしては、例えば次のものが挙げ 20 られる。mーフェニレンジアミン、2、4ージアミノト ルエン、2、4-ジアミノキシレン、2、4-ジアミノ デニレン、4-(1日、1日、11日-エイコサフルオ ロウンデカノキシ)-1,3-ジアミノベンゼン、4-(1H, 1H-パーフルオロー1ーブタノキシ) -1, 3-ジアミノベンゼン、4-(1日、1日-パーフルオ ロー1ーヘブタノキシ) -1, 3-ジアミノベンゼン、 4- (1H, 1H-パーフルオロー1-オクタノキシ) 1、3-ジアミノベンゼン、4-ペンタフルオロフェノ キシー1, 3-ジアミノベンゼン、4-(2, 3, 5, 6ーテトラフルオロフェノキシ) -1、3ージアミノベ ンゼン、4-(4-フルオロフェノキシ)-1、3-ジ アミノベンゼン、4-(1H, 1H, 2H, 2H-パー フルオロー1ーヘキサノキシ)ー1, 3ージアミノベン ゼン、4-(1H, 1H, 2H, 2H-パーフルオロー 1ードデカノキシ) -1, 3-ジアミノベンゼン、p-フェニレンジアミン、2、5-ジアミノトルエン、2、 3, 5, 6ーテトラメチルーpーフェニレンジアミン、 2, 5ージアミノベンプトリフルオライド、ビス (トリ フルオロメチル) フェニレンジアミン、ジアミノテトラ 40 (トリフルオロメチル) ベンゼン、ジアミノ (ベンタフ ルオロエチル) ベンゼン、2, 5-ジアミノ (パーフル オロヘキシル) ベンゼン、2、5ージアミノ (パーツル オロブチル) ベンゼン、ベンジジン、2, 2'ージメチ ルベンジジン、3、3'ージメチルベンジジン、3、 3'ージメトキシベンジジン、2,2'ージメトキシベ ンジジン、3、3′、5、5′ーテトラメチルベンジジ ン、3、3、…ジアセチルベンジジン、2、2…ビス (トリフルオロメチル) …4, 4' …ジアミノビフェニ ル、オクタフルオロベンジジン、3, 3' …ビス(トリ 50 アミノナフタレン、2, 6 …ジアミノナフタレン、ビス

フルオロメチル) -4, 4' -ジアミノビフェニル、 4, 4'ージアミノジフェニルエーテル、4, 4'ージ アミノジフェニルメタン、4,4' …ジアミノジフェニ ルスルホン、2, 2 ··· ピス (p ··· アミノフ::: ニル) プロ バン、3、3'ージメチルー4、4'ージアミノジフェ ニルエーテル、3,3' …ジメチル…4,4' …ジアミ ノジフェニルメタン、1、2…ビス(アニリノ)エタ ン、2、2-ビス (p-アミノフェニル) ヘキサフルオ ロプロパン、1、3-ビス(アニリノ) ヘキサフルオロ 10 プロバン、1, 4-ビス (アニリノ) オクタフルオロブ タン、1, 5-ビス (アニリノ) デカフルオロベンタ ン、1、7ービス(アニリノ)テトラデカフルオロヘブ タン、2, 2'ーピス(トリフルオロメチル)ー4. 4'ージアミノジフェニルエーテル、3、3'ーピス (トリフルオロメチル) -4, 4' -ジアミノジフェニ ルエーテル、3, 3', 5, 5'ーテトラキス (トリフ ルオロメチル) - 4、4° -ジアミノジフェニルエーテ ル、3、3'ービス(トリフルオロメチル)ー4、4' ージアミノベンソフェノン、4、 4'ージアミノーロー テルフェニル、1, 4ービス (p-アミノフェニル) ベ ンゼン、ロービス(4ーアミノー2ートリフルオロメチ ルフェノキシ)ベンゼン、ビス(アミノフェノキシ)ビ ス (トリフルオロメチル) ベンゼン、ビス (アミノフェ ノキシ)テトラキス(トリフルオロメチル)ベンゼン、 4, 4''' ージアミノーpークオーターフェニル、 4, 4'-ビス (p-アミノフェノキシ) ピフェニル、 2, 2-ビス (4- (p-アミノフェノキシ) フェニ ル) プロパン、4,4'ービス(3-アミノフェノキシ ジフェニル) ジフェニルスルホン、2、2-ビス (4-(4ーアミノフェノキシ) フェニル} ヘキサフルオロブ ロパン、2、2ービス {4-(3-アミノフェノキシ) フェニル トキサフルオロプロパン、2、2-ビス {4 - (2-アミノフェノキシ) フェニル} ヘキサフルオロ プロパン、2、2ーピス(4ーアミノフェノキ シ) -3, 5-ジメチルフェニル! ヘキサフルオロプロ パン、2, 2ービス {4-(4-アミノフェノキシ) -3, 5-ジトリフルオロメチルフェニル) ヘキサフルオ ロプロパン、4,4'ーピス(4-アミノー2ートリフ ルオロメチルフェノキシ) ビフェニル、4,4'ービス (4-アミノー3-トリフルオロメチルフェノキシ) ビ フェニル、4,4'ーピス(4ーアミノー2ートリフル オロメチルフェノキシ) ジフェニルスルホン、4,4' ーピス (3ーアミノー5ートリフルオロメチルフェノキ シ) ジフェニルスルホン、2, 2-ピス {4-(4-ア ミノー3ートリフルオロメチルフェノキシ) フェニル ヘキサフルオロプロパン、ビス ((トリフルオロメチ ル) アミノフェノキシ) ピフェニル、ビス [{(トリフ ルオロメチル) アミノフェノキシ! フェニル] ヘキサフ ルオロブロパン、ジアミノアントラキノン、1、5…ジ

30

(2-[(アミノフェノキシ) フェニル] ヘキサフルオ ロイソプロピル) ベンゼン、ビス(2,3,5,6ーデ トラフルオロ…4…アミノフェニル) エーテル、ビス (2、3、5、6ーデトラフルオロー4ーアミノフェニ ル) スルフィド、1, 3ーピス(3ーアミノプロビル) テトラメチルジシロキサン、1, 4…ビス(3…アミノ プロピルジメチルシリル) ベンゼン、ビス(4…アミノ フェニル) ジエチルシラン、1、3-ジアミノテトラフ ルオロバンゼン、1、4ージアミノテトラフルオロベン ゼン、4, 4'ービス(テトラフルオロアミノフェノキ 10 シ) オクタフルオロビフェニル等がある。

【0019】あとで述べるように、感光性基を導入する 際にはこれらがOH基で置換されたものが必要となる。

【0020】本発明に使用する含フッ素ボリイミドの前 駆体である含フッ素ポリアミド酸の製造方法は、通常の ポリアミド酸の製造条件と同じでよく、…般的にはN-メチルー2ービロリドン、N, Nージメチルアセトアミ ド、N、Nージメチルホルムアミドなどの極性有機溶媒 中で反応させる。本発明においてはジアミンとテトラカ ルボン酸またはその誘導体とも単…化合物で用いるばか 20 りではなく、複数のジアミン、テトラカルボン酸または その誘導体を混合して用いる場合がある。その場合は、 複数または単…のジアミンのモル数の合計と複数または 単…のテトラカルボン酸またはその誘導体のモル数の合 計が等しいかほぼ等しくなるようにする。

【0021】本発明に使用する感光性含フッ素ポリイミ ドの前駆体である含フッ森ポリイミドは、まず、含フッ 案ポリアミド酸を上記溶媒中で反応させたあと、mーキ シレンなどを加えて加熱し、共沸により脱水、イミド化 反応させる。このあとで感光性基を導入する。

【0022】感光性幕を導入する方法は通常の方法で良 い。そのひとつの例として、あらかじめ上紀デトラカル ボン酸あるいはその誘導体およびジアミンのうちのどち らか…方または両方にあらかじめOH基を持つモノマー を用い、このOH基を塩化シンナモイル、塩化アクリロ イル等の酸クロライドと反応させる方法がある。この感 光性基導入に際しては主鎖の重合後、ポリマーとなって から行なってもよい。

【0023】本発明においては、本発明の薄波層、クラ とくに好ましく、以下にその製法を示すが、それぞれ通 常用いられる他の導波層、クラッド層、接着性増強層組 み合わせて用いることももちろん可能である。

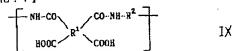
【0024】シロキサン変性含フッ楽ポリイミド前駆体 をガラス、シリコンなどの無機基板上に塗布し、通常の 方法でイミド化して、前配一般式VIIで表される繰り返 し単位を 1 種またはそれ以上有するシロキサン変性含フ ッ素ポリイミドとし、接着性増強層を製造する。これは 一般にフッ素の含有量が多くなると無機材との密着性が きわめて悪くなるため、そのような欠点を改良するため 50 12

のものである。ただし、市販のポリイミドフィルム、ポ リカーボネート板等の有機材料を基板とした場合は、こ のシロキサン変性フッ素化ポリイミド前駆体を接着性増 強屬として用いる必要はない。

【0025】上記シロキサン変性含フッ素ポリイミド前 駆体は、下記式IXで表される繰り返し単位を1種または それ以上有する。

[0026]

【化17】



(武中、R1は前記式目と間じ意味を表し、各繰り返し 単位のR2のうち一部は下記式VIII

【化18】

(式中、Rは独立してアルキル基を表す)で表される基

であり、他のR2は前記式111と同じ意味を表す(この場 合、Xは前記式IVと同じ意味を表し、並びにRI、R' fおよびR"fは前記式Vと同じ意味を表すが、R2にお いてどのR fも感光性基R⁰でない場合を含む)) 含フッ素ポリイミド前駆体を上記接着性増強層または有 機蒸板上に塗布し、200℃以上に加熱してイミド化し て、舶記一般式VIで表される繰り返し単位を1種または それ以上有する含フッ案ポリイミドとし、クラッド層を

【0027】上記含フッ素ポリイミド前駆体は下紀式X で表される繰り返し単位を1種またはそれ以上有する。

[0028]

30 製造する。

【化19】 Χ

(武中、R¹は前記式目と同じ意味を表し、R²は前記式 ッド層、接着性増強層を合わせて用いる光導波路素子が 40 目1と同じ意味を変し(ただし、R2においてどのRfも 感光性基R⁰でない場合を含む)、Xは前記式IVと同じ 意味を表し、並びにRI、R'fおよびR"Iは前記式 Vと間じ意味を表す) 。

> 【0029】さらに、この上に感光性フッ素化ポリイミ ドを塗布し、越光して露光部分と未露光部分との間に屈 折率差を生じさせる。このとき、このボリマー溶液には あらかじめ屈折率差を生じさせるための低分子量の添加 剤を加えておき、酵光後に加熱によりこの添加剤を蒸発

【0030】さらに、得られた導波チャネル上にさらに

前記の含フッ素ボリイミド前駆体を強布し、加熱により イミド化し、上記クラッド層を設けることができる。 【0031】なお、屈折率差を生じさせるために使用す る低分子量の添加剤には、架橋剤として用いられるビニ ルモノマー (例えば、スチレン、ビニルトルエン) 、ア クリル化合物(例えば、アクリル酸、2…エチルヘキシ ルアクリレート)、メタクリル化合物 (例えば、メタク リル酸、メチルメタクリレート、エチルメタクリレー ト) ; 光重合開始剤として用いられるベンジルジメチル ケタール、1-フェニルー1、2-プロパンジオンー2 10 - (O-エトキシカルボニル) オキシム、ベンソフェノ ン、ベンジル、ベンゾイソプロピルエーテル;増感剤と して用いられるビス (4-ジメチルアミノフェニル) ケ トン、4、4'ービスジエチルアミノベンソフェノン: 光架橋剤として用いられる4,4'ージアジドカルコ ン、1, 3ービス(4'ーアジドベンザル)アセトン、 2、6-ビス(4)-アジドベンザル)シクロヘキサノ ン、2,6-ビス(4'-アジドベンザル)-4-メチ ルシクロヘキサノン、2、6-ビス(4'-アジドベン ザル) メチルーシクロヘキサノンー2, 2'ージスルホ 20 ン酸ナトリウム塩等が含まれる。ここで用いる低分子量 の添加剤として、…般に主剤である感光性フッ素化ポリ イミドの電子吸収と比較して、これが短波長にある添加 剤を用いれば酵光部分の屈折率は未蔵光部分よりも低く なり、長波長にある添加剤を用いれば逆に健光部分の方 が高い屈折率となる。このように制御したうち高屈折率 となる部分を導波チャネルとすればよい。具体的な例と して、添加剤をメチルメタクリレートとすれば、៩光部 分は未露光部分より屈折率が低くなり、ベンジルを用い れば高くなる。ただし、電子吸収波長からこの制御性を 判断するのはあくまでも一般的な指針であり、現実的に は、実験によりこれを確認することが必要となる。これ は、主剤、添加剤ともに屈折率の複雑な波長分散をもっ ているためで、さらには、光反応により起こるのは、添 加剤の主剤に対する付加度応のみならず、架橋反応等も 同時に起こる可能性があり、このことにおいても複雑だ からである。

[0032]

に詳しく説明する。なお、種々のポリイミドの組み合わせにより、また種々の光導波路構造により数限りない本発明のポリイミド系導波路が得られることは明らかであるから、本発明はこれらの実施例のみに限定されるものではない。なお、光伝機損失は作製した光導波路に波投1、3μmの光を通してカットバック法で測定した。【0033】また、導波路出射端面からの光を対物レンズでCCDカメラに集光し、Photon社製ビームク

ラバーモデル6100により出射ビームパターンを解析

【実施例】以下いくつかの実施例を挙げて本発明をさら

[0034]

した。

14

【実施例1】ジメチルアセトアミド (DMAc) 500 ml中に窒素察測気下で、2,2ービス [4-(4ーアミノフェノキシ) フェニル] ヘキサフルオロプロバンを41.44g、東芝シリコン社製.TSL9386を、16.04g溶解させた。充分溶解したのち、ヘキサフルオロイソプロピリデンー2,2ービス (無水フタル酸) (6FDA) 44.4gを粉末のまま加えた。この溶液を窓温で窒素等囲気下で3日間撹拌したのち、0.2ミクロンのフィルターに通した。これを溶液Aとする。

[0035]

【実施例2】 DMA c 4 0 0 m 1 中に窒素雰囲気下で2, 2 ーピス [4 ー (4 ー アミノフェノキシ) フェニル] ヘキサフルオロブロバンを 4 3. 7 g 溶解させた。 充分溶解させたのち、6 F DA 5 6. 4 g を粉末のまま加えた。この溶液を窯温窒素雰囲気下で3 日間撹拌させたのち、0. 2 ミクロンのフィルターに通した。これを溶液 B とする。

[0036]

【実施例3】 Nーメチルピロリドン(NMP) 11中に 窒素雰囲気下で2、2-ビス(3-アミノー4-ヒドロ キシフェニル) ヘキサフルオロプロバン25.3g、 2, 2-ビス [4-(4-アミノフェノキシ) フェニ ル] ヘキサフルオロブロパン35.92gを溶解させ た。充分溶解させたのち、6FDA 61.58gを粉 末のまま加えた。この溶液を室温窒素雰囲気下で3日間 撹拌させた。さらにこの溶液にm-キシレンを250m 1加え、150℃に加熱、弱い減圧下にて、共沸による 脱水化(イミド化)を皮応させた。留去回収した共沸混 合物の水相が理論量となるまで(約4時間)この操作を 続けたのち、得られたポリマー溶液を水に滴下させ、再 沈させた。沈澱物を回収し、充分乾燥させたのち、テト ラヒドロキシフラン (TMF) 500mlに溶解させ た。この溶液にトリエチルアミン27.97gを加え、 これに塩化アクロイルIOwt% THF溶液を徐々に 滴下した。滴下しおえたあと2日間撹拌を続ける。これ を水に再沈し、沈澱物を回収、乾燥、THFに溶解し、 再び水に再沈、この操作を3回繰り返す。ポリマーを充 分乾燥させたのち、シクロヘキサノンに溶解し、30w t%溶液とする。これに、ポリマー100gに対して、 ベンジル23.23gミビラースケトン1gを加える。 これを0.2ミクロンフィルターに通し、これを溶液C とする。

[0037]

【実施例4】実施例2と間様の方法で得たポリアミック 酸溶液を、水にて再沈、沈澱物を回収、乾燥させ、nー ヘキサノール10w (%溶液とし0.2ミクロンフィル ターに通した。これを溶液Dとする。

[0038]

50 【実施例 5】シリコン基板上に上記溶液Aをスピンコー

15

ト法により塗布し、窒素パージしたオーブンで、70℃ 2時間、100℃2時間、160℃2時間、230℃2 時間で熱処理し、これを接着性増強層とした。この上に 溶液Bをスピンコート法により塗布し、90℃ホットプ レート上で90秒間、窒素パージしたオープンで、16 0℃2時間、230℃2時間熱処理し、下部クラッド層 とした。さらにこの上に、溶液Cを最終的な厚みが10 ミクロン程度となるようにスピンコート法により塗布 し、90℃ホットブレート上で3分間熱し、溶媒を蒸着 させ樽波路パターンのあるフォトマスクを通し、高圧水 10 銀灯の光を5分間照射した。さらにそののち、窒素バー ジしたオープンで、160℃8時間熱処理し、埋め込み 型導波路構造を得た。さらにこの上に溶液Dをスピンコ ート法により途布し、90℃ホットプレート上で90 秒、窒素パージしたオーブンで160℃2時間、230 ℃2時間で熱処理し、導波路デバイスを作製した。

[0039

【実施例 6】上述のようにして得た尊波路をシリコン基

16

板のへキ機により、端面を整え、単一モード光ファイバーからの光を端面結合法により導波路に伝搬させた。出射光を対物レンズを用い、CCDカメラに導入し、ビームの形状を解析すると単一モードであることが確認された。またカットバック法により導液損失を示すと、O.2dB/cmであった。また1×8分岐導波路にては8分岐していることが確認された。

[0040]

【実施例7】市販のポリイミドフィルム上に実施例5と 同様の手法で光導波路を形成し、フレキシブル導波路が 得られることを確認した。ただし、ここでは溶液Aを用 いなかった。

[0041]

【発明の効果】本発明によれば従来の石英系導波路ではできない作製プロセスの簡単化、低コスト化、フレキシブル化が可能となり、従来のプラスチック系導波路ではできない単一モード性、1.3ミクロン帯の低損失化、高耐湿性化が可能となった。

21 · · ·